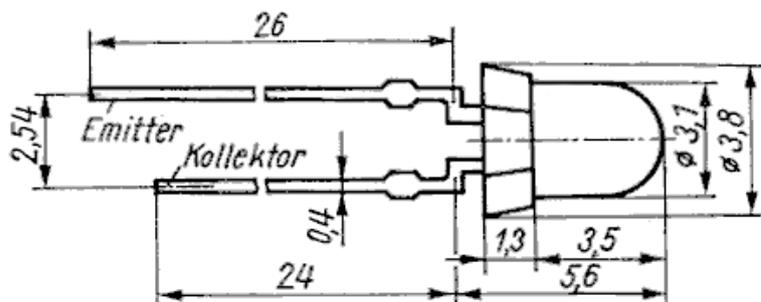


## SP 213

Si-npn-Planar-Fototransistor in 3 mm Allplast-Linsenverpackung. Die spektrale Empfindlichkeit des SP 213 ist dem Einsatz in Verbindung mit GaAs-IREDD angepaßt.

Bauform 12



Kennwerte bei $\vartheta_a$ 25 °C	min.	max.
Kollektorstrom bei $E_v = 1\,000\text{ lx}$ $U_{CE} = 5\text{ V}$	$I_c$	
ungruppiert	1,0	— mA
SP 213 A	1,0	2,0 mA
SP 213 B	1,6	3,2 mA
SP 213 C	2,5	5,0 mA
SP 213 D	3,6	— mA
Kollektor-Dunkelstrom bei $E_e = 0$ $U_{CE} = 25\text{ V}$	$I_{CO}$	100 nA
Öffnungswinkel	$\Theta$	60 °
Schaltzeit	$t_r, t_f$	10 $\mu\text{s}$
Wellenlänge der max. spektralen Empfindlichkeit	$\lambda_{\text{max}}$	850 nm
Spektraler Empfindlichkeits- bereich	$\Delta\lambda$	450 ... 1 050 nm
Kollektor-Emitter- Spannung	$U_{CEO}$	50 V
Emitter-Kollektor- Spannung	$U_{ECO}$	7 V
Gesamtverlust- leistung	$P_{\text{tot}}$	100 mW
Betriebstemperaturbereich $\vartheta_a$		-40 ... +85 °C
Lagerungstemperatur- bereich	$\vartheta_{\text{stg}}$	-50 ... +100 °C